

ТРАНЗИСТОРЫ

| Тип | Аналог | Технология | $P_{к\max}, \text{Вт}$ | $U_{кэ\max}, \text{В}$ | $I_{к\max}, \text{А}$ | $h_{21Э}$ | $U_{кэ\text{нас.}}$ не более, В | $I_{к\text{БЭ}}$ не более, А | $f_{гр}, \text{МГц}$ | $t_{рас}$ не более, нс | Корпус | ТУ |
|---|--------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|----------|-----------------------------|
| Радиационно-стойкие транзисторные сборки | | | | | | | | | | | | |
| 2Т689АС | 2N3799 | 4 p-n-p | 0,4 | 45 | 0,3 | 50-150 | 1,0 | 0,007 | - | - | 401.14-6 | аА0.339.758ТУ |
| 2Т689АС ОСМ | | | | | | | | | | | | аА0.339.758ТУ ПО.070.052 |
| 2Т690АС | 2N4123 | 4 n-p-n транзистора | 0,4 | 45 | 0,3 | 50-150 | 0,8 | 0,005 | - | 165 | 401.14-6 | аА0.339.759ТУ |
| 2Т690АС ОСМ | | | | | | | | | | - | | аА0.339.759ТУ ПО.070.052 |

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ

401.14-6

